1. **S. Shimomura, T. Toritsuka, A. Uenishi, Takahiro Kitada *and* S. Hiyamizu :** 1.3μm range effectively cylindrical In0.53Ga0.47As/In0.52Al0.48As quantum wires grown on (221)A InP substrates by molecular beam epitaxy, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.32,** *No.1-2,* 346-349, 2006.
2. **Y. Higuchi, S. Osaki, Takahiro Kitada, S. Shimomura, Y. Takasuka, M. Ogura *and* S. Hiyamizu :** Room temperature lasing of GaAs quantum wire vertical-cavity surface-emitting lasers grown on (775)B GaAs substrates by molecular beam epitaxy, *Solid-State Electronics,* **Vol.50,** *No.6,* 1137-1140, 2006.
3. **Jun Inoue, Toshiro Isu, Kouichi Akahane *and* Masahiro Tsuchiya :** Saturable absorption of highly stacked InAs quantum dot layer in 1.5 μm band, *Applied Physics Letters,* **Vol.89,** *No.15,* 151117, 2006.
4. **I. Watanabe, K. Shinohara, Takahiro Kitada, S. Shimomura, Y. Yamashita, A. Endoh, T. Mimura, S. Hiyamizu *and* T. Matsui :** Velocity enhancement in cryogenically cooled InP-based HEMTs on (411)A-oriented substrates, *IEEE Transactions on Electron Devices,* **Vol.53,** *No.11,* 2842-2846, 2006.
5. **H. Sagisaka, Takahiro Kitada, S. Shimomura, S. Hiyamizu, I. Watanabe, T. Matsui *and* T. Mimura :** Suppression of surface segregation of silicon dopants during molecular beam epitaxy of (411)A In0.75Ga0.25As/In0.52Al0.48As pseudomorphic high electron mobility transistor structures, *Journal of Vacuum Science & Technology B,* **Vol.24,** *No.6,* 2668-2671, 2006.
6. **Yu Higuchi, Shinji Osaki, Yoshifumi Sasahata, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Mutsuo Ogura *and* Satoshi Hiyamizu :** 830-nm Polarization Controlled Lasing of InGaAs Quantum Wire Vertical-Cavity Surface-Emitting Lasers Grown on (775)B GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.7,* L138-L141, 2007.
7. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Selective generation of quantum beats of weakly confined excitons, *Proceedings of International conference on physics of semiconductors,* **Vol.3,** 78, Viena, Austria, Jul. 2006.
8. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Enhancement of nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films by spectrally rectangle-shape-pulse-excitation, *International conference on nanoscience and technology,* **Vol.600,** 164, Basel, Switzerland, Jul. 2006.
9. **Y. Sasahara, S. Osaki, T. Fujita, A. Uenishi, T. Toritsuka, K. Ohmori, Y. Higuchi, K. Miyajima, Takahiro Kitada, S. Shimomura, T. Itoh *and* S. Hiyamizu :** Room temperature lasing action of vertical cavity surface emitting laser with self-organized InGaAs quantum wire grown on the (775)B InP substrates by molecular beam epitaxy, *33rd International Symposium on Compound Semiconductors,* 31, The University of British Columbia, Vancouver, Canada, Aug. 2006.
10. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *33rd International Symposium on Compound Semiconductors,* 113, Vancouver, Aug. 2006.
11. **Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Surface segregation of indium atoms during molecular beam epitaxy of InGaAs/GaAs superlattices on (n11)A GaAs substrates, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 30, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
12. **I. Watanabe, K. Shinohara, Takahiro Kitada, S. Shimomura, A. Endoh, Y. Yamashita, T. Mimura, S. Hiyamizu *and* T. Matsui :** Thermal stability of Ti/Pt/Au ohmic contacts for cryogenically cooled InP-based HEMTs fabricated on (411)A-oriented substrates by MBE, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 166, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
13. **S. Shimomura, T. Toritsuka, K. Ohmori, A. Uenishi, Takahiro Kitada *and* S. Hiyamizu :** Room temperature operation of 1.2um range self-organized quantum wire lasers grown on a (221)A InP substrates by molecular beam epitaxy, *14th International Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 327, Waseda University, Tokyo, Sep. 2006.
14. **S. Kusunoki, H. Sagisaka, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** High Schottky AlAs barriers inserted into pseudomorphic InGaAs/InAlAs HEMT structures with (411)A super-flat interfaces grown by MBE, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 70, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
15. **S. Osaki, Y. Higuchi, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Optical properties of GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wires grown on (775)B GaAs substrates by MBE, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 89, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
16. **T. Fujita, Takahiro Kitada, S. Shimomura *and* S. Hiyamizu :** Gain spectra of self-organized GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wire laser grown on (775)B GaAs substrates by molecular beam epitaxy, *24th North American Conference on Molecular Beam Epitaxy,* 90, Duke University, Durham, NC, USA, Oct. 2006.
17. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Nonlinear optical response of weakly confined excitons, *Kobe Frontier Technology Forum,* 38, Kobe, Nov. 2006.
18. **A. Kanno, Toshiro Isu, O. Kojima, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *5th International Symposium on Nanotechnology,* **Vol.P3-18,** *No.176,* Tokyo, Feb. 2007.
19. **Toshiro Isu, J. Inoue, K. Akahane, H. Sotobayashi *and* M. Tsuchiya :** Nonlinear absorption of highly stacked InAs quantum dot layers on an InP(311) substrate, *Proceedings of SPIE,* **Vol.6393,** 639309-1-639309-9, Washington, D.C., Mar. 2007.
20. **T. Fujita, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Gain Spectra of self-organized GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wire laser groun on (775)B GaAs substrates by moleclar beam epitaxy, *25th Electron Material Symposium,* 306-307, 2006年7月.
21. **S. Osaki, Y. Higuchi, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Optical properties of GaAs/(GaAs)4(AlAs)2 quantum wires grown on (775)B GaAs substrates by MBE, *25th Electron Material Symposium,* 316-317, 2006年7月.
22. **S. Kusunoki, H. Sagisaka, 北田 貴弘, S. Shimomura, S. Hiyamizu :** Pseudomorphic InGaAs/InAlAs HEMT structures with high Schottky AlAs barriers grown on (411)A InP substrates by MBE, *25th Electron Material Symposium,* 82-83, 2006年7月.
23. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons, *25th Electron Material Symposium,* Jul. 2006.
24. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子の超高速非線形光学応答, *応用物理学会中国四国支部学術講演会,* 2006年7月.
25. **楠 真一郎, 北田 貴弘, 下村 哲 :** (411)A InGaAs/InAlAs変調ドープ歪量子井戸構造における異方性評価, *第67回応用物理学会学術講演会,* 287, 2006年8月.
26. **下村 哲, 笹畑 圭史, 大森 和幸, 鳥塚 哲郎, 上西 敦士, 北田 貴弘, 小倉 睦郎, 冷水 佐壽 :** 自己形成型量子細線のMBE成長とレーザ·面発光レーザへの応用, *第67回応用物理学会学術講演会,* 30, 2006年8月.
27. **尾崎 信二, 樋口 裕, 北田 貴弘, 下村 哲, 冷水 佐壽 :** (775)GaAs基板上にMBE成長した自己形成型GaAs/(GaAs)4(AlAs)2量子細線のフォトルミネッセンス温度依存性, *第67回応用物理学会学術講演会,* 1282, 2006年8月.
28. **藤田 剛也, 大森 和幸, 北田 貴弘, 下村 哲, 冷水 佐壽 :** (775)GaAs基板上にMBE成長した自己形成型GaAs/(GaAs)4(AlAs)2量子細線レーザの利得スペクトル, *第67回応用物理学会学術講演会,* 1282, 2006年8月.
29. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子による超高速非線形光学応答, *第67回応用物理学会学術講演会,* 2006年8月.
30. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜における弱閉じ込め励起子の量子ビート, *日本物理学会2006年秋季大会,* 2006年9月.
31. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜閉じ込め励起子の時間分解分光, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
32. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子による非線形光学応答, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
33. **石川 陽, 井須 俊郎, 石原 一 :** 共振器QED系での励起子分子効果による2光子非線形性の理論, *第17回光物性研究会,* 2006年12月.
34. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 土屋 昌弘 :** 超高速光スイッチに向けたGaAs系弱閉じ込め励起子の光学応答, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
35. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 励起レーザスペクトル制御による弱閉じ込め励起子の非線形光学応答, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
36. **菅野 敦史, Katouf Redouane, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs 弱閉じ込め励起子の時間分解フォトルミネッセンス, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* 2007年3月.
37. **R. Katouf, A. Kanno, O. Kojima, M. Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs Based devices by wafer fusion, *CREST「光電場のナノ空間構造による新機能デバイスの創製」チームシンポジウム,* Mar. 2007.
38. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子の発光ダイナミクス, *日本物理学会2007年春季大会,* 2007年3月.
39. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子の非線形光学応答に対する励起子準位間干渉効果, *日本物理学会2007年春季大会,* 2007年3月.
40. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子非線形光学応答の複数準位励起効果, *第54回応用物理学関係連合講演会,* 2007年3月.
41. **菅野 敦史, 井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子の光学応答, *第54回応用物理学関係連合講演会,* 2007年3月.
42. **Issei Watanabe, Keisuke Shinohara, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Akira Endoh, Yoshimi Yamashita, Takashi Mimura, Satoshi Hiyamizu *and* Toshiaki Matsui :** Effects of Heterointerface Flatness on Device Performance of InP-Based High Electron Mobility Transistor, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.46,** *No.4B,* 2325-2329, 2007.
43. **Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura *and* Satoshi Hiyamizu :** Surface segregation of indium atoms during molecular beam epitaxy of InGaAs/GaAs superlattices on (n11)A GaAs substrates, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.301-302,** 172-176, 2007.
44. **Issei Watanabe, Keisuke Shinohara, Takahiro Kitada, Satoshi Shimomura, Akira Endoh, Yoshimi Yamashita, Takashi Mimura, Satoshi Hiyamizu *and* Toshiaki Matsui :** Thermal stability of Ti/Pt/Au ohmic contacts for cryogenically cooled InP-based HEMTs on(411)A-oriented substrates by MBE, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.301-302,** 1025-1029, 2007.
45. **Yusuke Kondo, Masaaki Ono, Shunichirou Matsuzaka, Ken Morita, Haruki Sanada, Yuzo Ohno *and* Hideo Ohno :** Multi Pulse Operation and Optical Detection of Nuclear Spin Coherence in a GaAs/AlGaAs Quantum Wells, *Physical Review Letters,* **Vol.101,** *No.20,* 207601, 2008.
46. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Ultrafast Optical Kerr Effect of Excitons Weakly Confined in GaAs Thin Films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.1,* 360-363, 2008.
47. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Decay of Orientational Grating of Weakly Confined Excitons in GaAs Thin Films, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 963-965, 2008.
48. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Effects of Excitation Spectral Width on Decay Profile of Weakly Confined Excitons, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 966-968, 2008.
49. **A. Kanno, R. Katouf, O. Kojima, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki, M. Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Dynamics of weakly confined Excitons in GaAs Thin Films, *Journal of Luminescence,* **Vol.128,** *No.5-6,* 1069-1071, 2008.
50. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast nonlinear optical response of weakly confined excitons in GaAs thin films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.4,** *No.5,* 1731-1734, Weinheim, May 2007.
51. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Sasaki, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Dynamics of weakly confined Excitons in GaAs Thin Films, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.Mo-P7-08,** 80, Segovia, Jun. 2007.
52. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki *and* M Tsuchiya :** Decay of Orientational Grating of Weakly Confined Excitons in GaAs Thin Films, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.We-P4-49,** 255, Segovia, Jun. 2007.
53. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, R Katouf, M Sasaki *and* M Tsuchiya :** Effects of Excitation Spectral Width on Decay Profile of Weakly Confined Excitons, *International Conference on DynamicalProcesses in Excited States of Solids (DPC07),* **Vol.We-P4-50,** 256, Segovia, Jun. 2007.
54. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Ultrafast Optical Kerr Effect of Excitons Weakly Confined in GaAs, *15th International Conference on Nonequilibrium Carrier Dynamics in Semiconductors(HCIS15),* **Vol.WeA-3,** Tokyo, Jul. 2007.
55. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.MoD P1,** 81, Kyoto, Oct. 2007.
56. **N Niki, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strained Quantum Wells on High Index Substrates, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.ThD P6,** 341, Kyoto, Oct. 2007.
57. **Takahiro Kitada, S Kusunoki, M Kinouchi, Ken Morita, Toshiro Isu *and* S Shimomura :** Isotropic Interface Roughness of Pseudomorphic In0.74Ga0.26As/In0.52Al0.48As Quantum Wells Grown on (411)A InP Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *The 34th International Symposium on Compound Semiconductors (iscs2007),* **Vol.ThD P5,** 340, Kyoto, Oct. 2007.
58. **井須 俊郎, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(311)B上のInAs量子ドットの光学異方性, *第3回量子ナノ材料セミナー,* 1-4, 2007年6月.
59. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, R. Katouf, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Interference effects on degenerate four-wave-mixing signals by weakly confined exciton states, *26th Electron Material Symposium, No.G5,* 159-160, Jul. 2007.
60. **T Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada, K Akahane, N Yamamoto *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of InAs quantum dots on an InP(113)B substrate, *26th Electron Material Symposium,* **Vol.G6,** 161-162, Jul. 2007.
61. **A Kanno, R Katouf, O Kojima, J Ishi-Hayase, M Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Dynamics of excitons weakly confined in GaAs thin films by time-resolved photoluminescence measurements, *26th Electron Material Symposium,* **Vol.G7,** 162-163, Jul. 2007.
62. **井須 俊郎 :** 光電場のナノ空間構造を利用した超高速光スイッチの開発, *ナノテクデバイス研究会,* 68-69, 2007年7月.
63. **Kojima O., Toshiro Isu, Ishi-Hayase J., Kanno A., Katouf R., Sasaki M. *and* Tsuchiya M. :** Interference effects between weakly confined exciton states on exciton dephasing, *ナノテクデバイス研究会,* 126-127, Jul. 2007.
64. **菅野 敦史, Redouane Katouf, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中の弱閉じ込め励起子の発光ダイナミクスおよび，光カー効果を用いた全光スイッチ応用の検討, *ナノテクデバイス研究会,* 128-129, 2007年7月.
65. **Katouf R., Kanno A., Kojima O., Ishi-Hayase J., Tsuchiya M. *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs based photonic devices by wafer fusion, 130-131, Jul. 2007.
66. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** PLによる高指数面上InGaAs歪量子井戸の光学異方性評価, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-5,** 92, 2007年8月.
67. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 大きな非線形光学応答を実現するGaAs/AlAs多層膜構造の検討, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-6,** 93, 2007年8月.
68. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 山本 直克, 井須 俊郎 :** (113)B InAs量子ドットのフォトルミネッセンスによる光学異方性, *応用物理学会中国四国支部2007年度支部学術講演会,* **Vol.Ea-7,** 94, 2007年8月.
69. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子系の非線形光学応答に対する残留キャリア効果, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.4a-ZK-12,** 1461, 2007年9月.
70. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(113)B上の積層InAs量子ドットの光学異方性, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.6a-N12,** 1413, 2007年9月.
71. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜構造における光電場強度の増大効果, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-2,** 1418, 2007年9月.
72. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 高指数(11n)面上のInGaAs歪量子井戸の光学異方性, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-3,** 1418, 2007年9月.
73. **菅野 敦史, Redouane Katouf, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** 弱閉じ込め励起子系における光カー効果のピコ秒応答, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.7a-N-4,** 1419, 2007年9月.
74. **北田 貴弘, 楠 慎一郎, 木内 将登, 森田 健, 下村 哲, 井須 俊郎 :** (411)A InGaAs/InAlAs 変調ドープ歪量子井戸構造における界面ラフネスの異方性評価, *第68回応用物理学会学術講演会,* **Vol.8a-H-2,** 345, 2007年9月.
75. **小島 磨, 井須 俊郎, 早瀬(伊師) 潤子, 菅野 敦史, Katouf Redouane, 佐々木 雅英, 土屋 昌弘 :** 弱閉じ込め励起子の配向緩和, *日本物理学会第62回年次大会,* **Vol.23pPSA-91,** 769, 2007年9月.
76. **岩見 勝弘, 熊井 亮太, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 中河 義典, 井須 俊郎 :** フェムト秒レーザー照射に伴う4H-SiC上での電気伝導度変化の検討, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会講演会予稿集,* **Vol.16,** 129-130, 2007年11月.
77. **菅野 敦史, Katouf Redouane, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中弱閉じ込め励起子のサブピコ秒光カー効果, *第18回光物性研究会,* **Vol.IIA-48,** 191-194, 2007年12月.
78. **渡辺 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** スペクトル分解反射型ポンプ・プローブ法によるGaAs薄膜中閉じ込め励起子の過渡応答測定, *第18回光物性研究会,* **Vol.IIA-47,** 187-190, 2007年12月.
79. **北田 貴弘, 森田 健, 井須 俊郎 :** 面型超高速光スイッチに向けた半導体多層膜のMBE成長, *応用物理学会中国四国支部研究会,* 2007年12月.
80. **井須 俊郎 :** ナノ半導体による新規光デバイスの創製, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2007年12月.
81. **向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 赤羽 浩一, 山本 直克 :** InP(113)B基板上InAs量子ドットのフォトルミネッセンス光学異方性, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-11,** 2007年12月.
82. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 高指数GaAs面上InGaAs歪量子井戸の光学異方性, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-12,** 2007年12月.
83. **神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 大きな非線形光学応答のためのGaAs/AlAs 多層膜構造の光電場強度増大効果, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-13,** 2007年12月.
84. **北田 貴弘, 楠 真一郎, 木内 将登, 森田 健, 下村 哲, 井須 俊郎 :** 電子移動度によるInGaAs/InAlAs へテロ界面の異方性評価, *第1回フロンティア研究センターシンポジウム,* **Vol.P-14,** 2007年12月.
85. **井須 俊郎, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, Katouf Redouane, 菅野 敦史, 土屋 昌弘 :** GaAs閉じ込め励起子ポラリトンによる超高速光スイッチ, *JSTナノテクノロジー分野別バーチャルラボ成果報告会,* PB6-1, 2008年1月.
86. **渡部 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における複数準位励起下での閉じ込め励起子の過渡反射スペクトル, *日本物理学会第63回年次大会, No.26a-PS-27,* 2008年3月.
87. **カトフ レドワン, 菅野 敦史, 山本 直克, 井須 俊郎, 外林 秀之, 土屋 昌弘 :** GaAs ナノ細線光導波路の作製と評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
88. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs (001)および(113)B基板上へのInAs量子ドットのMBE成長と光学特性評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
89. **森田 健, 神原 敏之, 仲野 翔也, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜における時間分解非線形光学応答, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
90. **小島 磨, 宮川 歩弓, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の超高速非線形応答の励起光強度依存性, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
91. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 有限障壁ポテンシャルを考慮した高指数GaAs (11n)A基板上のInGaAs歪量子井戸の光学異方性評価, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
92. **神原 敏之, 仲野 翔也, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** AlAs/Al0.3Ga0.7Asダブルエッチストッパー構造を有するGaAs/AlAs多層膜構造の作製, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
93. **北田 貴弘, 神原 敏之, 森田 健, 井須 俊郎 :** マトリックス法によるGaAs/AlAs多層膜構造の光カー信号強度のシミュレーション, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
94. **菅野 敦史, カトフ レドワン, 小島 磨, 早瀬(伊師) 潤子, 土屋 昌弘, 井須 俊郎 :** 多連パルス入射時の弱閉じ込め励起子光カー効果サブピコ秒応答, *第55回応用物理学関係連合講演会,* 2008年3月.
95. **O. Kojima, Toshiro Isu, J. Ishi-Hayase, J. Ishi-Hayase, A. Kanno, M. Sasaki *and* M. Tsuchiya :** Ultrafast response induced by interference effects between weakly confined exciton states, *Journal of the Physical Society of Japan,* **Vol.77,** *No.4,* 044701, 2008.
96. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2858-2860, 2008.
97. **Takahiro Kitada, S Kusunoki, M Kinouchi, Ken Morita, Toshiro Isu *and* S Shimomura :** Isotropic Interface Roughness of Pseudomorphic In0.74Ga0.26As/In0.52Al0.48As Quantum Wells Grown on (411)A InP Substrates by Molecular Beam Epitaxy, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2753-2755, 2008.
98. **Nobuyoshi Niki, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strained Quantum Wells on High Index Substrates, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2756-2759, 2008.
99. **Takahiro Kitada, Toshiyuki Kanbara, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs Multilayer Cavity with Self-Assembled InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Ultrafast All-Optical Switching Applications, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.9,* 092302, 2008.
100. **Takahiro Kitada, Nobuyoshi Niki, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of(11n)-Oriented InGaAs Strained Quantum Wells with Finite Barrier Potential Calculated with Mixing Effects of the Spin-Orbit Split-Off Band, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.47,** *No.10,* 7839-7841, 2008.
101. **R. Katouf, N. Yamamoto, A. Kanno, N. Sekine, K. Akahane, H. Sotobayashi, Toshiro Isu *and* M. Tsuchiya :** Ultrahigh Relative Refractive Index Contrast GaAs Nanowire Waveguides, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.12,* 122101, 2008.
102. **Osamu Kojima, Ayumi Miyagawa, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Ultrafast all-optical control of excitons confined in GaAs thin films, *Applied Physics Express,* **Vol.1,** *No.11,* 112401, 2008.
103. **Ken Morita, Kanbara Toshiyuki, Yano Shinsuke, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Asymmetric temporal profile of optical Kerr signal from GaAs/AlAs multilayer with /2 phase shift layer, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.1,* 137-140, 2009.
104. **O Kojima, A Miyagawa, T Kita, Toshiro Isu *and* O Wada :** Optical Cancellation of exciton population in GaAs thin films, *3rd International Laser, Light-Wave and Microwave Conference 2008,* **Vol.24-TP1-1,** Yokohama, Apr. 2008.
105. **R. Katouf, A. Kanno, N. Yamamoto, N. Sekine, K.T. Liang, K. Sasagawa, K. Akahane, Toshiro Isu, H. Sotobayashi *and* M. Tsuchiya :** 15 dB cross loss modulation by cw pump injection of mW-class in 1.5-mm long nano-wire waveguide, *Conference on Lasers and Electro-Optics(CLEO2008),* San Jose, U.S.A., May 2008.
106. **Ken Morita, Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Asymmetric temporal profile of optical Kerr signal from GaAs/AlAs multilayer with λ/2 phase shift layer, *The 8th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON2008),* **Vol.OP-IV-03,** Kyoto, Jun. 2008.
107. **O. Kojima, A. Miyagawa, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Optical control of residual excitons for ultrafast nonlinear response in GaAs thin films, *The 8th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter (EXCON2008),* **Vol.P-53,** Kyoto, Jun. 2008.
108. **O Kojima, Toshiro Isu, J Ishi-Hayase, M Sasaki, A Kanno, R Katouf *and* M Tsuchiya :** Spectral Width Dependence of Residual Carrier Effect on Nonlinear Optical Response of Weakly Confined Excitons, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.5,** *No.9,* 2858-2860, Jul. 2008.
109. **S. Watanabe, O. Kojima, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Transient reflectivity response with negative time delay caused by femtosecond pulse propagation in GaAs thin films, *Third International Conference on Optical, Optoelectronic and Photonic Materials and Applications,* Edmonton, Canada, Jul. 2008.
110. **Takahiro Kitada, T. Mukai, T. Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Fast carrier relaxation of self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barriers for ultrafast nonlinear optical switching applications, *15th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2008), No.3-V FA1.6,* Vancouver, Aug. 2008.
111. **T. Mukai, T. Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of carrier relaxation in self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barrier layers, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.E-1-4,** Tsukuba, Sep. 2008.
112. **T. Kanbara, S. Nakano, S. Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced two-photon absorption in a GaAs/AlAs multilayer cavity, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.E-2-5,** Tsukuba, Sep. 2008.
113. **T. Takahashi, .T Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Molecular beam epitaxy of self-assembled InAs quantum dots on (001) and (113)B GaAs substrates under a slow growth rate condition, *2008 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2008),* **Vol.F-5-2,** Tsukuba, Sep. 2008.
114. **Ken Morita, T. Kanbara, S. Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities for a short pulse, *35th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2008),* **Vol.P35,** Rust,Germany, Sep. 2008.
115. **Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-resolved two-photon absorption measurements of GaAs/AlAs multilayer with λ/2 GaAs layer, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.J13,* 211, Jul. 2008.
116. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication and optical properties of self-assembled InAs quantum dots grown on GaAs(001) and (113)B substrates, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.K9,* 235, Jul. 2008.
117. **S. Watanabe, O. Kojima, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation effect on transient response of excitons confined in GaAs thin films, *27th Electronic Materials Symposium(EMS27), No.J14,* 213, Jul. 2008.
118. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットの分子線エピタキシャル成長と光学特性評価, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Ep-05,** 2008年8月.
119. **神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造の作製と二光子吸収特性評価, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-07,** 2008年8月.
120. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlGaAs 量子井戸の二光子励起フォトルミネッセンス, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-05,** 2008年8月.
121. **高橋 朋也, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs 基板上InAs 量子ドットの分子線エピタキシャル成長とフォトルミネッセンス測定, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Ep-06,** 2008年8月.
122. **矢野 慎介, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜共振器構造におけるQ値と光カー信号強度, *応用物理学会中国四国支部2008年度支部学術講演会,* **Vol.Fa-09,** 2008年8月.
123. **高橋 朋也, 向井 拓也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットのMBE成長, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(2a-CF-16),* 2008年9月.
124. **今津 晋二郎, 松木 豊和, 毛利 如良, 藤田 剛也, 北田 貴弘, 下村 哲 :** (775)B GaAs基板上にMBE成長したGaAs/(GaAs)4(AlAs)2自己形成型量子細線レーザのゲインスペクトル3, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3p-ZQ-6),* 2008年9月.
125. **神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 二光子共鳴量子井戸を有するGaAs/AlAs 多層膜共振器構造の作製, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-2),* 2008年9月.
126. **森田 健, 神原 敏之, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器の非対称時間分解光カー信号, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-3),* 2008年9月.
127. **矢野 慎介, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造における光カー信号強度の層数依存性, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-4),* 2008年9月.
128. **北田 貴弘, 神原 敏之, 矢野 慎介, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器構造の光カー信号強度のQ 値依存性のシミュレーション, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-5),* 2008年9月.
129. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (001)量子井戸における二光子吸収の光学異方性, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-6),* 2008年9月.
130. **小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の密度制御, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(3a-ZQ-7),* 2008年9月.
131. **岩見 勝弘, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 中河 義典, 井須 俊郎, 齋藤 伸吾 :** フェムト秒レーザー照射により改質されたSiCの電気伝導特性, *第69回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* **Vol.69,** *No.3,* 999, 2008年9月.
132. **向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットの高速キャリア緩和, *2008年秋季第69回応用物理学会学術講演会(4p-ZQ-16),* **Vol.Ep-05,** 2008年9月.
133. **森田 健, 仁木 伸義, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 二光子励起フォトルミネッセンス分光におけるGaAs/AlGaAs量子井戸の光学異方性, *第19回光物性研究会,* **Vol.3B-100,** 402-405, 2008年12月.
134. **渡部 真吾, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子ポラリトン伝播効果, *第19回光物性研究会,* **Vol.3B-105,** 422-425, 2008年12月.
135. **向所 明里, 向井 拓也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和In0.35Ga0.65As 層に埋め込んだInAs量子ドットの作製とその光学特性, *第29回レーザー学会学術講演会, No.F-10pVI-2,* 2009年1月.
136. **仁木 伸義, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs量子井戸における二光子吸収の偏光方向異方性, *第29回レーザー学会学術講演会, No.F-10pVI-3,* 2009年1月.
137. **熊井 亮太, 富田 卓朗, 森田 健, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎 :** 100kHzフェムト秒レーザーを用いた半導体へのナノ周期構造の作製, *レーザー学会学術講演会第29回年次大会講演予稿集,* **Vol.29,** 125, 2009年1月.
138. **井須 俊郎 :** ナノ半導体による新規光デバイスの創製に向けて, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
139. **北田 貴弘 :** 超高速光スイッチに向けたInAs量子ドットのMBE成長, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
140. **森田 健 :** GaAs/AlAs多層膜共振器構造の非線形光学応答, *第2回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2009年3月.
141. **小島 磨, 渡部 真吾, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子過渡応答に対する空間コヒーレンス効果, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
142. **井須 俊郎, 田中 文也, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘 :** 2つの共振器モードを実現するGaAs/AlAs多層膜結合共振器構造, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
143. **田中 文也, 神原 敏之, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造における第二高調波・和周波発生, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
144. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和InGaAsバリア層に埋め込んだInAs量子ドットのキャリア緩和におけるドーピング効果, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
145. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 共振器層に過飽和吸収特性を有するGaAs/AlAs多層膜共振器構造, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
146. **森田 健, 高橋 朋也, 神原 敏之, 向井 拓也, 矢野 慎介, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層中のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器における光カー信号, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
147. **高橋 朋也, 向井 拓也, 向所 明里, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器のMBE成長, *第56回応用物理学関係連合講演会,* 2009年3月.
148. **小島 磨, 井須 俊郎 :** Dynamics of Excitons Confined in Semiconductor Thin Films, High-Power and Femtosecond Lasers : Properties, Materials and Applications (Lasers and Electro-optics Research and Technology), 2009年7月.
149. **Ken Morita, Haruki Sanada, Shunichirou Matsuzaka, Yuzo Ohno *and* Hideo Ohno :** Intersubband exchange interaction induced by optically excited electron spins in GaAs/AlGaAs quantum wells, *Applied Physics Letters,* **Vol.94,** *No.16,* 162104, 2009.
150. **Shingo Watanabe, Osamu Kojima, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Transient reflectivity response with negative time delay caused by femtosecond pulse propagation in GaAs thin films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.S1,* S139-S142, 2009.
151. **Takuya Mukai, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of carrier relaxation in self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barrier layers, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C106, 2009.
152. **Toshiyuki Kanbara, Shoya Nakano, Shinsuke Yano, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced two-photon absorption in a GaAs/AlAs multilayer cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C105, 2009.
153. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Photoluminescence Properties of Self-Assembled InAs Quantum Dots Grown on (001) and (113)B GaAs Substrates by Molecular Beam Epitaxy under a Slow Growth Rate Condition, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.4,* 04C128, 2009.
154. **Ken Morita, Toshiyuk Kanbara, Shinsuke Yano, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities for a short pulse, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.6,* 1420-1423, 2009.
155. **Takahiro Kitada, Takuya Mukai, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Fast carrier relaxation of self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed In0.35Ga0.65As barriers for ultrafast nonlinear optical switching applications, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.311,** *No.7,* 1807-1810, 2009.
156. **Takahiro Kitada, Toshiyuki Kanbara, Shinsuke Yano, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked Enhancement of Optical Kerr Signal in Proportion to Fourth Power of Quality Factor of a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.48,** *No.8,* 080203, 2009.
157. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced Optical Kerr Signal of GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers, *Applied Physics Express,* **Vol.2,** *No.8,* 082001, 2009.
158. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures for terahertz emission devices, *Applied Physics Letters,* **Vol.95,** *No.11,* 111106, 2009.
159. **Takuro Tomita, Masahiro Iwami, Minoru Yamamoto, Manato Deki, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shingo Saito, Kiyomi Sakai, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Electronic properties of femtosecond laser induced modified spots on single crystal silicon carbide, *Materials Science Forum,* **Vol.645-648,** 239-242, 2010.
160. **Atsushi Kanno, Redouane Katouf, Osamu Kojima, Junko Ishi-Hayase, Masahiro Tsuchiya *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr response to multi pump pulses on GaAs weakly confined exciton, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.6,** *No.6,* 1509-1512, Wiley-VCH, Apr. 2009.
161. **Takahiro Kitada, A. Mukaijyo, T. Takahashi, T. Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Doping effect on photocarrier lifetime in InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers grown by molecular beam epitaxy, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Mo-mP54,** 66, Kobe, Jul. 2009.
162. **Ken Morita, T. Takahashi, T. Kanbara, S. Yano, T. Mukai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Large optical Kerr signal of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Mo-mP59,** 71, Kobe, Jul. 2009.
163. **S. Shimomura, T. Fujita, S. Imadu *and* Takahiro Kitada :** Anisotropic modal gain spectra of GaAs self-assembled quantum-wire laser structures on (775)B GaAs substrates, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Tu-mP27,** 141, Kobe, Jul. 2009.
164. **O. Kojima, S. Watanabe, T. Kita, O. Wada *and* Toshiro Isu :** Spatial coherence effect on transient response of confined excitons in GaAs thin films, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.Th-mP7,** 226, Kobe, Jul. 2009.
165. **Ken Morita, H. Sanada, S. Matsuzaka, Y. Ohno *and* H. Ohno :** Two-color pump-probe measurements of intersubband excitonic interactions in GaAs/AlAs quantum wells, *The 14th International Conference on Modulated Semiconductor Structures (MSS-14),* **Vol.M6e,** 204, Kobe, Jul. 2009.
166. **Takahashi Tomoya, Kanbara Toshiyuki, Mukai Takuya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Molecular Beam Epitaxy of InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Layers, *Second International Workshop on Epitaxial Growth and Fundamental Properties of Semiconductor Nanostructures (SemicoNano2009),* **Vol.P-19,** Annan, Aug. 2009.
167. **Toshiro Isu, Takahashi Tomoya, Kanbara Toshiyuki, Mukai Takuya, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr Signals of a GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Layers, *Second International Workshop on Epitaxial Growth and Fundamental Properties of Semiconductor Nanostructures (SemicoNano2009),* **Vol.O-12,** Annan, Aug. 2009.
168. **Toshiro Isu, Kanbara Toshiyuki, Takahashi Tomoya, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities with two-photon resonant quantum wells in the half-wavelength layer, *The 36th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2009), No.p1.15,* 123, University of California, Santa Barbara, USA, Sep. 2009.
169. **Ken Morita, Niki Nobuyoshi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of two-photon absorption in GaAs/AlGaAs quantum wells measured by photoluminescence, *The 36th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2009), No.p1.13,* 119, University of California, Santa Barbara, USA, Sep. 2009.
170. **Takahashi Tomoya, Mukai Takuya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers for planar-type optical Kerr gate switches, *2009 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2009),* **Vol.I-6-5,** Sendai, Oct. 2009.
171. **Tanaka Fumiya, Takahashi Tomoya, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong sum frequency generation in a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity grown on a (113)B-oriented GaAs substrate, *2009 International Conference on Solid State Devices and Materials(SSDM2009),* **Vol.I-9-2,** Sendai, Oct. 2009.
172. **Tomoyasu Nakada, Masanobu Haraguchi, Yoshinori Nakagawa, Masuo Fukui, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Fabrication of a grating coupler in surface plasmon polariton (SPP) waveguide by scanning probe microscope (SPM) lithography, *Abstract of the 7-th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics (APNFO-7),* 70, Jeju, Nov. 2009.
173. **Takae Yamashita, Osamu Kojima, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Effective dipole moments of excitons in GaAs thin films, *Workshop on Information, Nano and Photonics Technology 2009 (WINPTech 2009),* Kobe, Dec. 2009.
174. **野村 英矩, 熊井 亮太, 富田 卓朗, 森田 健, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 井須 俊郎 :** シリコン表面上で生成されるリップル構造のパルス数及びフルエンス依存性, *第56回応用物理学関係連合講演会講演予稿集,* **Vol.56,** *No.3,* 1180, 2009年4月.
175. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 福井 萬壽夫, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** プローブ陽極酸化リソグラフィー法による微細グレーティング加工に関する研究, *第56回応用物理学会学関係連合講演会 講演予稿集,* **Vol.2,** *No.1a-TE-4,* 708, 2009年4月.
176. **井須 俊郎 :** 半導体多層膜共振器を用いた面型全光カーゲートスイッチ, *神戸大学連携推進本部ナノ・フォトニクス技術セミナー,* 2009年5月.
177. **北田 貴弘 :** 超高速光スイッチに向けたInAs量子ドットの分子線エピタキシャル成長, *神戸大学連携推進本部ナノ・フォトニクス技術セミナー,* 2009年5月.
178. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Akari Mukaijo, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in straiu-relaxed barriers for ultrafast all-optical switch, *28th Electronic Materials Symposium(EMS28), No.F4,* 155-156, Jul. 2009.
179. **Fumiya Tanaka, Toshiyuki Kanbara, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Second harmonic and sum frequency generations of a coupled (113)B GaAs/AlAs multilayer cavity, *28th Electronic Materials Symposium(EMS28), No.J21,* 277-278, Jul. 2009.
180. **高橋 朋也, 向井 拓也, 向所 明里, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バイア層に埋め込んだInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器, *応用物理学会中国四国支部2009年度支部学術講演会,* **Vol.Dp2-2,** 97, 2009年8月.
181. **田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2つの共振器モードを有するGaAs/AlAs結合共振器構造による周波数混合信号の発生, *応用物理学会中国四国支部2009年度支部学術講演会,* **Vol.Dp2-3,** 98, 2009年8月.
182. **出来 真斗, 山本 稔, 伊藤 拓人, 岩見 勝弘, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** イオン注入電極を作製したSiC基板へのフェムト秒レーザー照射による電気伝導特性制御, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会・講演予稿集,* 1057, 2009年9月.
183. **北田 貴弘, 田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜結合共振器内部における2つの共振器モードの光干渉効果, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-5,* 1286, 2009年9月.
184. **高橋 朋也, 田中 文也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/Air 多層膜共振器の光カー信号強度のシミュレーション, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-2,* 1285, 2009年9月.
185. **田中 文也, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs (113)B 結合共振器における和周波信号強度の励起偏光方向依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-6,* 1287, 2009年9月.
186. **森田 健, 高橋 朋也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜共振器におけるps パルスを用いた光カー信号のQ 値依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9p-TH-1,* 1285, 2009年9月.
187. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 福井 萬壽夫, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 走査型プローブ顕微鏡リソグラフィーによる回折格子型表面プラズモン励起素子の作製, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.9a-ZM-6,* 946, 2009年9月.
188. **北田 貴弘, 向井 拓也, 高橋 朋也, 向所 明里, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだSi ドープInAs 量子ドットにおけるキャリア緩和の励起波長依存性, *2009年秋季・第70回応用物理学会学術講演会, No.10p-C-14,* 315, 2009年9月.
189. **森田 健, 高橋 朋也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜共振器における光カー信号の励起光強度依存性, *2009年秋季第70回応用物理学会学術講演会, No.10p-C-13,* 314, 2009年9月.
190. **山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜の励起子非線形光学応答制御における第一パルス光強度依存性, *日本物理学会2009年秋季大会, No.27aPS-28,* 2009年9月.
191. **山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 和田 修, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子の双極子モーメント, *第20回光物性研究会, No.A-83,* 341, 2009年12月.
192. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 山本 稔, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** 6H-SiC基板へのフェムト秒レーザー改質による電気伝導のパルスピッチ依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会講演会予稿集,* **Vol.18,** 148-149, 2009年12月.
193. **北田 貴弘, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs量子ドットをもつGaAs/AlAs多層膜光共振器による面型全光スイッチ, *2010年光エレクトロニクス研究会,* **Vol.109,** *No.401,* OPE2009-189, 2010年1月.
194. **北田 貴弘, 高橋 朋也, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットにおける高速キャリア緩和, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.17p-TW-14,* 2010年3月.
195. **田中 文也, 高橋 朋也, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2つの共振器モードを有する(113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器の時間分解和周波信号測定, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.17a-TM-22,* 2010年3月.
196. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** 回折格子型表面プラズモンポラリトン励起素子の特性, *第57回応用物理学関係連合講演会 講演予稿集,* **Vol.17a-P1-21,** 2010年3月.
197. **森田 健, 田中 文也, 高橋 朋也, 滝本 隼主, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 2パルスによる(113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の和周波・第二高調波スペクトルの遅延時間依存性, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-M-1,* 2010年3月.
198. **森田 健, 高橋 朋也, 田中 文也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ピコ秒パルスを用いたInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器構造の光カー信号, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-N-7,* 2010年3月.
199. **高橋 朋也, 田中 文也, 張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 選択エッチングによるGaAs/Air多層膜共振器構造の作製, *第57回応用物理学関係連合講演会, No.18a-TM-24,* 2010年3月.
200. **森田 健 :** GaAs/AlAs非結合・結合共振器構造を利用した非線形ダイナミクス, *イーグル若手研究会,* 2010年3月.
201. **北田 貴弘 :** InAs量子ドットとGaAs/AlAs多層膜共振器構造の超高速光スイッチ, *第4回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2010年3月.
202. **森田 健 :** 多層膜結合光共振器構造による周波数混合信号の発生, *第4回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2010年3月.
203. **Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong Sum Frequency Generation in a GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity Grown on a (113)B-Oriented GaAs Substrate, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DG01, 2010.
204. **Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Planar-Type Optical Kerr Gate Switches, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.49,** *No.4,* 04DG02, 2010.
205. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Strongly Enhanced Sum Frequency Generation in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *Applied Physics Express,* **Vol.3,** *No.7,* 072801, 2010.
206. **Ken Morita, Nobuyoshi Niki, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of two-photon absorption in GaAs/AlGaAs quantum wells measured by photoluminescence, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.10,* 2482-2485, 2010.
207. **Toshiro Isu, Toshiyuki Kanbara, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Optical Kerr signals of GaAs/AlAs multilayer cavities with two-photon resonant quantum wells in the half-wavelength layer, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.7,** *No.10,* 2478-2481, 2010.
208. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Doping effect on photocarrier lifetime in InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers grown by molecular beam epitaxy, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.42,** *No.10,* 2540-2543, 2010.
209. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Toshiyuki Kanbara, Shinsuke Yano, Takuya Mukai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Large optical Kerr signal of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers, *Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures,* **Vol.42,** *No.10,* 2505-2508, 2010.
210. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Excitation wavelength dependence of photocarrier relaxation in Si-doped InAs quantum dots with strain-relaxed InGaAs barriers, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 334-336, 2011.
211. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation Velocity of Excitonic Polaritons Confined in GaAs Thin Films, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.8,** *No.2,* 378-380, 2011.
212. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Dephasing of excitonic polaritons confined in GaAs thin films, *Journal of the Physical Society of Japan,* **Vol.80,** *No.3,* 034704-1-034704-5, 2011.
213. **Manato Deki, Takuto Ito, Minoru Yamamoto, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Enhancement of local electrical conductivities in SiC by femtosecond laser modification, *Applied Physics Letters,* **Vol.98,** *No.13,* 133104-1-133104-3, 2011.
214. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Flockert Michael, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton excitation by a Phase Shift Grating, *World Academy of Science Engineering and Technology,* **Vol.74,** 24-28, 2011.
215. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strong optical Kerr gate signal in InAs-dot-buried GaAs/AlAs multilayer cavity using a picosecond laser pulse, *Quantum Dot 2010, No.p.57,* East Midlands Conference Center,Nottingham,UK, Apr. 2010.
216. **Osamu Kojima, Shingo Watanabe, Takashi Kita, Osamu Wada *and* Toshiro Isu :** Propagation Velocity of Excitonic Polaritons Confined in GaAs Thin Films, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrE1-4,* 353, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
217. **Takahiro Kitada, Akari Mukaijo, Tomoya Takahashi, Takuya Mukai, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Excitation Wavelength Dependence of Photocarrier Relaxation in Si-Doped InAs Quantum Dots with Strain-Relaxed InGaAs Barriers, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrP15,* 377, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
218. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Anisotropy of Enhanced Sum-Frequency Generation Signal in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *The 37th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2010), No.FrP18,* 379, Takamatsu Symbol Tower, Kagawa, Japan, Jun. 2010.
219. **Toshiro Isu, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Toshikazu Takimoto, Ken Morita *and* Takahiro Kitada :** Frequency-M-xing-Signal Generation on a GaAs/AlAs Coupled Multilayer-Cavity, *9th International Conference on Excitonic and Photonic Processws in Condensed and Nano Materials (EXCON'10),* **Vol.13O02,** Novotel Hotel, Brisbane, Australia, Jul. 2010.
220. **Manato Deki, Minoru Yamamoto, Ito Takuto, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Ohshima :** Femtosecond laser modification aiming at the enhancement of local electric conductivities in SiC, *30th International Conference on the Physics of Semiconductors,* P1-306, Seoul, Jul. 2010.
221. **Takahiro Kitada, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked reduction in photocarrier lifetime by erbium doping into self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *16th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE2010), No.p1.20,* bcc Berlin Congress Center, Berlin, Germany, Aug. 2010.
222. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Flockert Michael, Toshihiro Okamoto, Masuo Fukui, Toshiro Isu, T Okazaki *and* Gen-ichi Shinomiya :** Modulator for Surface Plasmon Polariton Using LiNbO3:Ti Plasmon Waveguide, *11th International Conference on Near-field Nano Optics, Nanophotonics& Related Techniques (NFO-11),* Beijing, Aug. 2010.
223. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Remarkable Enhancement of Optical Kerr Signal by increasing Quality Factor in a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *2010 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2010), No.D-1-4,* 59-60, Tokyo, Sep. 2010.
224. **Fumiya Tanaka, Toshikazu Takimoto, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-Resolved Measurements on Sum Frequency Generation Strongly Enhanced in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *2010 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2010), No.D-2-1,* 61-62, Tokyo, Sep. 2010.
225. **Manato Deki, Takuro Ito, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Oshima :** Laser Modification Aiming at the Enhancement of Local Electrical Conductivities in SiC, *The 9th International Workshop on Radiation Effects on Semiconductor Devices for Space Applications,* 218-221, Takasaki, Oct. 2010.
226. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Novel terahertz emission devices based on efficient optical frequency conversion in GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures on high-index substrates, *SPIE Photonics West2011, No.OPTO7937-52,* The Moscone Center San Francisco, California, USA, Jan. 2011.
227. **Tomoyasu Nakada, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Flockert Michael, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton excitation by a Phase Shift Grating, *International Conference on Nanotechnology, Optoelectronics and Photonics (ICNOP) 2011,* 24, PENANG,MALAYSIA, Feb. 2011.
228. **原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** ナノLEDの開発, *LED総合フォーラム論文集,* 67-68, 2010年4月.
229. **Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical anisotropy of sum-frequency generation in a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity, *29th Electronic Materials Symposium (EMS-29), No.We3-5,* 57, Jul. 2010.
230. **Ken Morita, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr gate switching in InAs-dot-buried GaAs/AlAs multilayer cavity using a wavelength restricted picosecond laser pulse, *29th Electronic Materials Symposium (EMS-29), No.We3-7,* 61, Jul. 2010.
231. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトンを利用したレジスト厚計測, *応用物理学会 中国四国支部 2010年度 支部学術講演会, No.Aa2-5,* 2010年7月.
232. **田辺 新平, 中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトンを利用したグルコースセンサー, *応用物理学会 中国四国支部 2010年度 支部学術講演会, No.Aa2-4,* 2010年7月.
233. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** SiCのフェムト秒レーザー改質部における局所電気伝導度の照射フルエンス依存性, *第71 回応用物理学会学術講演会講演予稿集,* 04-269, 2010年9月.
234. **森田 健, 田中 文也, 滝本 隼主, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 分極反転したGaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の作製とその光学特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.14a-G-3,* 05-041, 2010年9月.
235. **上山 日向, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットの電気特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.15a-ZV-4,* 15-058, 2010年9月.
236. **田中 文也, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 非対称なGaAs/AlAs多層膜結合共振器の作製とその光学特性, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-7,* 14-070, 2010年9月.
237. **北田 貴弘, 田中 文也, 滝本 隼主, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜結合共振器における非線形分極構造の制御, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-6,* 14-069, 2010年9月.
238. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜におけるレーザースペクトル幅制御による励起子応答制御, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.16a-NC-8,* 14-071, 2010年9月.
239. **中田 智康, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン励起のためのスラブ導波路上の位相シフト回折格子結合器の評価, *2010年秋季 第71回 応用物理学会学術講演会, No.17a-NJ-6,* 03-140, 2010年9月.
240. **五井 恵太, 山下 太香恵, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子状態の制御性, *2010年秋季大会 日本物理学会, No.25pPSB-31,* 731, 2010年9月.
241. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー改質したSiCにおける局所電気伝導度の照射フルエンス依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第19回講演会 予稿集,* 114-115, 2010年10月.
242. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** SiCのフェムト秒レーザー改質部における局所電気伝導度の照射偏光依存性, *SiC及び関連ワイドギャップ半導体研究会 第19回講演会 予稿集,* 110-111, 2010年10月.
243. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子応答に対する検出パルスのスペクトル幅の効果, *WINPTech2010 Workshop on Information, Nano and Photonics Technology 2010,* 2010年12月.
244. **五井 恵太, 小島 磨, 山下 太香恵, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における閉じ込め励起子状態の光制御, *第21回光物性研究会(2010), No.A-57,* 2010年12月.
245. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 検出パルス制御によるGaAs薄膜中の閉じ込め励起子の超高速応答, *第21回光物性研究会(2010), No.A-84,* 2010年12月.
246. **森田 健 :** 量子ドットを用いた面型多層膜超高速全光スイッチ, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2011年2月.
247. **北田 貴弘 :** 半導体結合光共振器によるテラヘルツ光発生素子, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム,* 2011年2月.
248. **森田 健, 加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 多層膜結合共振器構造へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.24a-KF-4,* 04-157, 2011年3月.
249. **上山 日向, 高橋 朋也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットの作製とその光学特性, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.24p-BQ-4,* 15-061, 2011年3月.
250. **西中 一平, 美藤 邦彦, 木股 雅章, 内藤 聖貴, 山本 泰志, 片山 晴善, 佐藤 亮太, Patrashin Mikhail, 寳迫 巌, 井須 俊郎, 北田 貴弘 :** GaSb/InAs Type-II超格子赤外線センサの開発, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KT-7,* 03-063, 2011年3月.
251. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 重心運動閉じ込め励起子の量子ビートの生成と検出, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-7,* 14-040, 2011年3月.
252. **北田 貴弘, 安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜三結合共振器の面型波長変換素子への応用, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-8,* 14-041, 2011年3月.
253. **滝本 隼主, 加藤 翔, 田中 文也, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合により作製したGaAs/AlAs多層膜結合共振器, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25a-KV-9,* 14-042, 2011年3月.
254. **中田 智康, 中河 義典, 田邉 新平, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン励起のためのブレーズド回折格子結合器の評価, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-3,* 03-188, 2011年3月.
255. **田邉 新平, 中河 義典, 中田 智康, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 二次元六方クラスター回折格子による表面プラズモン励起, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-4,* 03-189, 2011年3月.
256. **Michael Flockert, 田邉 新平, 中河 義典, 中田 智康, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 小山 浩司, 四宮 源市 :** 二次元矩形クラスタープラズモニック格子による表面プラズモン励起, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.25p-BH-5,* 03-190, 2011年3月.
257. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射偏光依存性, *第58回応用物理学関係連合講演会,* 04-287, 2011年3月.
258. **加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造の二つの共振器モードを利用したテラヘルツ帯差周波発生, *第58回応用物理学関係連合講演会, No.26a-KB-2,* 05-106, 2011年3月.
259. **出来 真斗, 伊藤 拓人, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射強度および偏光依存性, *第5回フロンティア研究センターシンポジウム 「日亜寄附講座研究成果報告会」,* 10, 2011年2月.
260. **Ken Morita, Tomoya Takahashi, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Optical Kerr Signals Markedly Enhanced by Increasing Quality Factor in a GaAs/AlAs Multilayer Cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.50,** *No.4,* 04DG02, 2011.
261. **Fumiya Tanaka, Toshikazu Takimoto, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Time-Resolved Measurements on Sum-Frequency Generation Strongly Enhanced in (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.50,** *No.4,* 04DG03, 2011.
262. **Takahiro Kitada, Fumiya Tanaka, Tomoya Takahashi, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Novel terahertz emission devices based on efficient optical frequency conversion in GaAs/AlAs coupled multilayer cavity structures on high-index substrates, *Proceedings of SPIE,* **Vol.7937,** 1H-1, 2011.
263. **Takahiro Kitada, Tomoya Takahashi, Hyuga Ueyama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Marked reduction in photocarrier lifetime by erbium doping into self-assembled InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.323,** *No.1,* 241-243, 2011.
264. **Takuro Tomita, Ryota Kumai, Hidenori Nomura, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Surface roughness assisted 100 kHz femtosecond laser induced nanostructure formation on silicon surface, *Applied Physics. A, Materials Science & Processing,* **Vol.105,** *No.1,* 89-94, 2011.
265. **Takae Yamashita, Osamu Kojima, Takashi Kita *and* Toshiro Isu :** Depolarization effect on optical control of excition states confined in GaAs thin films, *Journal of Applied Physics,* **Vol.110,** *No.4,* 043514, 2011.
266. **Ken Morita, Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Fumiya Tanaka, Yoshinori Nakagawa, Shingo Saito, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Generation of Terahertz Radiation from Two Cavity Modes of a GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity, *Applied Physics Express,* **Vol.4,** *No.10,* 102102, 2011.
267. **Na Zhou, Tetsuya Suekane, Takahiro Hosokawa, Sadamu Inaoka *and* Qiuwang Wang :** In-situ capillary trapping of CO2 by means of co-injection, *Transport in Porous Media,* **Vol.90,** *No.2,* 575-587, 2011.
268. **Tetsuya Suekane *and* Hiroki Ushita :** Effect of buoyancy on pore-scale characteristics of two-phase flow in porous media, *CT Imaging,* **Vol.2,** 2011.
269. **Shohei Ohta, Osamu Kojima, Takashi Kita *and* Toshiro Isu :** Observation of quantum beat oscillations and ultrafast relaxation of excitons confined in GaAs thin films by controlling probe laser pulses, *Journal of Applied Physics,* **Vol.111,** 023505, 2012.
270. **Takuto Ito, Manato Deki, Takuro Tomita, Shigeki Matsuo, Shuichi Hashimoto, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Shinobu Onoda *and* Takeshi Oshima :** Electrical conduction properties of SiC modified by femtosecond laser, *Journal of Laser Micro/Nanoengineering,* **Vol.7,** *No.1,* 16-20, 2012.
271. **Haruyoshi Katayama, Junpei Murooka, Masataka Naitoh, Tadashi Imai, Ryota Sato, Eichi Tomita, Munetaka Ueno, Hiroshi Murakami, Satoshi Kawasaki, Kunihiko Bito, Masafumi Kimata, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Mikhail Patrashin *and* Iwao Hosako :** Development of type II superlattice detector for future space applications at JAXA, *Proceedings of SPIE,* **Vol.8353,** 2012.
272. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Tomoyasu Nakada, Masanobu Haraguchi, Michael Flockert, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface plasmon excitation by 2D-hexagonal plasmonic crystal, *The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP5) 2011,* **Vol.MP-14,** Busan, May 2011.
273. **Flockert Michael, Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Tomoyasu Nakada, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** 2D-gap mode plasmonic crystal on photonic fiber end face, *The 5th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP5) 2011,* **Vol.TuP-126,** Busan, May 2011.
274. **Ken Morita, Toshikazu Takimoto, Shou Katoh, Fumiya Tanaka, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with polarization inverted structure fabricated by wafer-bonding method, *The 38th International Symposium on Compound Semiconductors(ISCS2011), No.P4.102,* Berlin, Germany Maritim proArte Hotel, May 2011.
275. **Tetsuya Suekane, T. Izumi *and* K. Okada :** Capillary trapping of supercritical CO2 in porous media at the pore scale, *6th International Conference on Computational and Experimental Methods in Multiphase and Complex Flow,* Kos, Jun. 2011.
276. **Tetsuya Suekane :** Mechanisms of capillary trapping of CO2 at pore scale, *the 2nd International Environment Forum for CCS,* Seoul, Jul. 2011.
277. **Shimpei Tanabe, Yoshinori Nakagwa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Chirped grating coupler for surface plasmon polariton excitation fabricated by scanning probe microscope lithography, *The 8th Asia-Pacific Workshop on Nanophotonics and Near-Field Optics( APNFO),* Adelaide, Aug. 2011.
278. **Hiroaki Suzuki, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Toshihiro Okamoto :** Emission spectra from nano slit arrays on a LED electrode, *The 8th Asia-Pacific Workshop on Nanophotonics and Near-Field Optics( APNFO),* Adelaide, Aug. 2011.
279. **Tetsuya Suekane *and* K. Okada :** Pore scale imaging of supercritical CO2 trapped by capillarity in porous media, *4th International Workshop on Process Tomography,* Chenghu, Sep. 2011.
280. **Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz radiation from a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity by ultrashort laser pulse excitation, *2011 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2011), No.I-4-2,* Nagoya, Sep. 2011.
281. **Hyuga Ueyama, Tomoya Takahashi, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs multilayer cavity with Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers for ultrafast all-optical switches, *2011 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2011), No.I-5-1,* Nagoya, Sep. 2011.
282. **N. Zhou, Tetsuya Suekane, T. Hosokawa, H.T. Nguyen *and* Q.W. Wang :** Capillary trapping of carbon dioxide storage in geological formations, *2011 International Workshop on Heat Transfer Advances for Energy Conservation and Pollution Control,* Xi'an, Oct. 2011.
283. **Setiawan Arief, H. Nomura *and* Tetsuya Suekane :** Pore-scale trapping mechanisms of oil in porous medium, *2011 International Workshop on Heat Transfer Advances for Energy Conservation and Pollution Control,* Xi'an, Oct. 2011.
284. **鈴木 裕旭, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 金属膜上の多重スリットによるLED光取り出し制御, *LED総合フォーラム論文集,* 77-78, 2011年6月.
285. **Hyuga Ueyama, Tomoya Takahashi, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Optical properties of Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed barriers for an all-optical switch with a multilayer cavity structure, *第30回電子材料シンホ シ ウム(EMS-30), No.Th1-8,* 2011年6月.
286. **Syo Katoh, Toshikazu Takimoto, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Terahertz Difference-frequency Generation of two cavity modes in a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity, *第30回電子材料シンホ シ ウム(EMS-30), No.Th1-17,* 2011年6月.
287. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 遠藤 善紀, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 二次元六方プラズモン結合器の励起光波長依存性, *応用物理学会 中国四国支部 2011年度 支部学術講演会, No.Bp2-3,* 2011年7月.
288. **遠藤 善紀, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 田邉 新平, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** ツインリッジプラズモン導波路の作製と評価, *応用物理学会 中国四国支部 2011年度 支部学術講演会, No.Bp2-4,* 2011年7月.
289. **安長 千徳, 上山 日向, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 多層膜三結合共振器構造を用いた四光波混合による波長変換素子, *2011年度応用物理学会中国四国支部学術講演会, No.Bp2-1,* 2011年7月.
290. **張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/Air 微小光共振器構造の選択エッチングによる作製, *2011年度応用物理学会中国四国支部学術講演会, No.Ea2-4,* 2011年7月.
291. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源一 :** 表面プラズモンポラリトン広角励起用チャープグレーティングの作製, *第72回応用物理学会学術講演会,* **Vol.30p-P13-24,** 2011年8月.
292. **伊藤 拓人, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射によるSiC改質部の局所電気伝導度の照射偏光依存性Ⅱ, *第72回応用物理学会学術講演会,* 04-236, 2011年8月.
293. **北田 貴弘, 滝本 隼主, 加藤 翔, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs結合共振器に生じる非線形分極とテラヘルツ帯差周波発生, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31a-F-6,* 04-135, 2011年8月.
294. **森田 健, 加藤 翔, 滝本 隼主, 田中 文也, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs結合共振器における二つの共振器モードを利用したテラヘルツ帯差周波発生, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31a-F-7,* 04-136, 2011年8月.
295. **滝本 隼主, 加藤 翔, 田中 文也, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs多層膜結合共振器のテラヘルツ帯差周波発生の分極反転効果, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-6,* 14-037, 2011年8月.
296. **張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速光スイッチに向けたGaAs/Air 共振器構造の作製, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-5,* 14-036, 2011年8月.
297. **安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 波長変換機能を実現するGaAs/AlAs多層膜三結合共振器中の非線形分極, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-4,* 14-035, 2011年8月.
298. **小島 磨, 山下 太香恵, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜中の光電場に対する局所場の効果, *第72回応用物理学会学術講演会, No.31p-P16-3,* 14-034, 2011年8月.
299. **上山 日向, 高橋 朋也, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜共振器の作製と光学特性, *第72回応用物理学会学術講演会, No.1a-ZA-15,* 15-108, 2011年9月.
300. **加藤 翔, 滝本 隼主, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造におけるテラヘルツ帯差周波信号の励起偏光方向依存性, *第72回応用物理学会学術講演会, No.1p-ZN-4,* 05-073, 2011年9月.
301. **大田 翔平, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** 非共鳴励起下における励起子ポラリトンと光電場の結合, *第72回応用物理学会学術講演会, No.1p-K-9,* 14-071, 2011年9月.
302. **奥野 正士, 清田 正徳, 末包 哲也 :** らせん管型吸収器の水蒸気吸収性能について, *日本機械学会2011年度年次大会講演論文集(CD),* 2011年9月.
303. **五井 恵太, 小島 磨, 喜多 隆, 井須 俊郎 :** GaAs薄膜における励起子状態の光制御に対する入射光エネルギー依存性, *2011年秋季大会 日本物理学会, No.21aRB-9,* 2011年9月.
304. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 :** 半導体多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ波発生素子, *学振第182委員会第11回研究会 (テラヘルツ波科学技術と産業開拓委員会),* 2011年10月.
305. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 遠藤 善紀, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 楕円型回折格子による表面プラズモンポラリトン励起, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2011, No.29aE2,* 2011年11月.
306. **遠藤 善紀, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 田邉 新平, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 交差回折格子結合器によるSPP の二色性励起, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2011, No.29aE3,* 2011年11月.
307. **井須 俊郎 :** 半導体ナノ構造による新規光デバイスの創製, *精密工学会知能メカトロニクス専門委員会研究会,* **Vol.16,** *No.3,* 13, 2012年1月.
308. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健, 中河 義典 :** GaAs/AlAs多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ発光素子, *(社)レ-ザー学会学術講演会第32回年次大会, No.F-431pIV01,* 169, 2012年1月.
309. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健 :** 半導体多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ波発生, *第7回宇宙用高感度赤外センサ研究会,* 2012年2月.
310. **森田 健, 上山 日向, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加したInAs量子ドットをもつGaAs/AlAs多層膜光共振器による超高速全光スイッチ, *光エレクトロニクス研究会(OPE),* **Vol.111,** *No.448-449,* 31-34, 2012年3月.
311. **伊藤 拓人, 大西 諒, 出来 真斗, 富田 卓朗, 松尾 繁樹, 橋本 修一, 北田 貴弘, 井須 俊郎, 小野田 忍, 大島 武 :** フェムト秒レーザー照射による表面及び内部におけるSiC 改質部の電気伝導特性, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会,* 04-283, 2012年3月.
312. **上山 日向, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs量子ドットを1層有するGaAs/AlAs多層膜共振器のMBE成長, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.16p-A8-8,* 2012年3月.
313. **北田 貴弘, 滝本 隼主, 加藤 翔, 森田 健, 井須 俊郎 :** 超短パルス光照射によるGaAs/AlAs結合共振器からのテラヘル帯差周波発生とそのシミュレーション, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.16p-GP6-10,* 2012年3月.
314. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 表面プラズモンポラリトン広範励起用チャープグレーティングの作製, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.16p-GP1-20,* 2012年3月.
315. **上山 日向, 安長 千徳, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだInAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜共振器の四光波混合信号測定, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.17a-E1-7,* 2012年3月.
316. **森田 健, 滝本 隼主, 加藤 翔, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 分極反転したGaAs/AlAs結合共振器によるテラヘルツ帯差周波発生, *2012年春季 第59回 応用物理学関係連合講演会, No.18a-E8-11,* 2012年3月.
317. **井須 俊郎 :** テラヘルツLEDの実現を目指して, *第10回徳島大学研究者との集い(産学連携講演会),* 2011年11月.
318. **井須 俊郎 :** 半導体ナノ構造を使った新しい光デバイス技術開発∼未開拓の光発生素子を目指して∼, *LED・エネルギー市民フォーラム,* 2011年12月.
319. **Hyuga Ueyama, Tomoya Takahashi, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/AlAs Multilayer Cavity with Er-Doped InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed InGaAs Barriers for Ultrafast All-Optical Switches, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.51,** *No.4,* 04DG06, 2012.
320. **Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz Radiation from a (113)B GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity by Ultrashort Laser Pulse Excitation, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.51,** *No.4,* 04DG05, 2012.
321. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton grating coupler on the Ti diffused LiNbO3 channel waveguide, *World Academy of Science, Engineering and Technology,* **Vol.71,** 798-807, 2012.
322. **Ken Morita, Hyuga Ueyama, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs multilayer cavity with Er-doped InAs quantum dots embedded in extremely thin strain-relaxed InGaAs barriers for ultrafast all-optical switches, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.4,* 04CG04, 2013.
323. **Hidetada Komatsu, Zhao Zhang, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/Air Multilayer Cavity for a Planar-Type Nonlinear Optical Device, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.4,* 04CG06, 2013.
324. **Ken Morita, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz radiation using a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity, *The 10th International Conference on Excitonic Processes in Condensed Matter, Nanostructured and Molecular Materials(EXCON2012),* **Vol.P073,** Groningen, the Netherlands, Jul. 2012.
325. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Toshihiro Okamoto, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton Grating Coupler on Piezoelectric Material Bonded with Conductive Si (100) Substrate, *Abstract of the 12-th international Conference on Near-field Optics nanophotonics and Related Techniques (NFO-12),* 110, DONOSTIA-SAN SEBASTIAN, Sep. 2012.
326. **Takahiro Kitada, Hyuga Ueyama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Ultrafast photocarrier relaxation processes in Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *The 17th International Conference on Molecular Beam Epitaxy (MBE 2012), No.TuP-53,* Nara, Sep. 2012.
327. **Yukinori Yasunaga, Hyuga Ueyama, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strongly enhanced four-wave mixing signal from GaAs/AlAs cavity with InAs QDs embedded in strain-relaxed barriers, *2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), No.A-3-2,* Kyoto, Sep. 2012.
328. **Hidetada Komatsu, Zhao Zhang, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** A GaAs/Air multilayer cavity for a planar-type non-linear optical device, *2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), No.PS-7-19,* Kyoto, Sep. 2012.
329. **Ken Morita, Hyuga Ueyama, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs multilayer cavity with Er-doped InAs quantum dots embedded in extremely thin strain-relaxed InGaAs barriers for ultrafast alloptical switches, *2012 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM 2012), No.A-6-4,* Kyoto, Sep. 2012.
330. **S Katoh, Y Yasunaga, Y Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** InAs QDs embedded in strain-relaxed InGaAs barriers on (113)B GaAs substrates, *International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials(ICEAN2012), No.P2-084,* Brisbane,Austraria, Oct. 2012.
331. **Yukinori Yasunaga, Hyuga Ueyama, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing signal measurements of GaAs/AlAs multilayer cavity with InAs QDs embedded in strain-relaxed barriers, *International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials(ICEAN2012), No.P2-105,* Brisbane,Austraria, Oct. 2012.
332. **Takahiro Kitada, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Novel semiconductor quantum dots for ultrafast nonlinear optical devices, *International Conference on Emerging Advanced Nanomaterials(ICEAN2012), No.4C-IL-6,* Brisbane,Austraria, Oct. 2012.
333. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Surface Plasmon Polariton grating coupler on the Ti diffused LiNbO3 channel waveguide, *ICNOP 2012 : International Conference on Nanotechnology, Optoelectronics and Photonics,* Venice, Nov. 2012.
334. **Takahiro Kitada, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Molecular Beam Epitaxy of InAs Quantum Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers for Ultrafast Nonlinear Optical Devices, *Collaborative Conference on Crystal Growth (3CG), No.A7,* Orland, Florida, USA, Dec. 2012.
335. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Toshihiro Okamoto, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Fabrication and optical evaluation of 1D and 2D photonic metamaterial crystal, *Photonics Global Conference 2012,* **Vol.c12a512,** Singapore, Dec. 2012.
336. **H Komatsu, Z Zhang, Y Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** A GaAs/Air multilayer cavity for a planar-type non-linear optical devise GaA/Air, *第31回電子材料シンポジウム(EMS-31), No.Fr1-8,* 2012年7月.
337. **Y Yasunaga, H Ueyama, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Strongly enhanced four-wave mixing signal from GaAs/AlAs cavity, *第31回電子材料シンポジウム(EMS-31), No.Fr1-9,* 2012年7月.
338. **安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドット共振器による四光波混合信号の増強, *応用物理学会学中国四国支部2012 年度支部学術講演会, No.Cp-4,* 2012年7月.
339. **小松 秀士, 張 ミン, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 選択エッチングにより作製したGaAs/Air多層膜光共振器の反射率スペクトル測定, *応用物理学会学中国四国支部2012 年度支部学術講演会, No.Cp-3,* 2012年7月.
340. **田邉 新平, 中河 義典, 楠瀬 健, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** Ti 拡散LiNbO3 リッジ導波路上への表面プラズモンポラリトン励起用回折格子の作製, *応用物理学会学中国四国支部2012 年度支部学術講演会, No.Aa-8,* 2012年7月.
341. **北田 貴弘 :** 新規な非線形光学デバイスを目指した半導体ナノ構造のMBE成長, *和歌山大学-徳島大学 光・ナノテクノロジー研究会,* 2012年8月.
342. **森田 健 :** 半導体結合共振器による面型テラヘルツ波発生素子, *和歌山大学-徳島大学 光・ナノテクノロジー研究会,* 2012年8月.
343. **北田 貴弘, 上山 日向, 森田 健, 井須 俊郎 :** 歪緩和バリア層に埋め込んだEr添加InAs 量子ドットにおける超高速キャリア緩和の励起波長依存性, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.11p-F1-1,* 2012年9月.
344. **森田 健, 北田 貴弘, 赤羽 浩一, 井須 俊郎 :** 通信波長帯多重積層InAs 量子ドット中のスピン緩和, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.11p-F1-2,* 2012年9月.
345. **安長 千徳, 上山 日向, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 波長変換機能を実現するGaAs/AlAs 多層膜三結合共振器の四光波混合信号の時間分解測定, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.12a-F1-2,* 2012年9月.
346. **加藤 翔, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs基板上に作製した歪緩和In0.45Ga0.55Asバリア層に埋め込んだInAs量子ドット, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.12a-J-9,* 2012年9月.
347. **富田 卓朗, 尾崎 信彦, 菅野 智士, 江山 剛史, 高吉 翔大, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlGaAs多重量子井戸におけるフェムト秒レーザーアブレーション, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.12p-PA4-6,* 2012年9月.
348. **田邉 新平, 中河 義典, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 四宮 源市 :** 単結晶ダイヤモンド基板上に作製された表面プラズモンポラリトン励起用回折格子型結合器の特性評価, *2012年秋季第73回応用物理学会学術講演会, No.13a-PA4-5,* 2012年9月.
349. **鈴木 裕旭, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** LED の金属電極部に形成した回折格子構造による発光制御, *日本光学会年次学術講演会 Optics & Photonics Japan 2012 講演予稿集, No.24pE3,* 2012年10月.
350. **森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器によるテラヘルツ光発生, *電子情報通信学会電子デバイス研究会, No.ED2012-96,* 17-21, 2012年12月.
351. **北田 貴弘, 原山 千穂, 森田 健, 井須 俊郎 :** InAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 結合共振器による二波長面発光レーザの室温光励起発振, *2013年第60回応用物理学会春季学術講演会, No.28a-G20-8,* 2013年3月.
352. **井須 俊郎 :** 超高速非線形光学デバイスと応用電子物性分科会, *2013年第60回応用物理学会春季学術講演会, No.28p-G14-5,* 2013年3月.
353. **小松 秀士, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 選択エッチングにより作製したGaAs/Air多層膜共振器構造の反射率面内分布, *2013年第60回応用物理学会春季学術講演会, No.30a-G20-12,* 2013年3月.
354. **Yukinori Yasunaga, Hyuga Ueyama, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Strongly Enhanced Four-Wave Mixing Signal from GaAs/AlAs Cavity with InAs Quanynm Dots Embedded in Strain-Relaxed Barriers, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.52,** *No.4,* 04CG09, 2013.
355. **Shinpei Tanabe, Yoshinori Nakagawa, Toshihiro Okamoto, Masanobu Haraguchi, Toshiro Isu *and* Genichi Shinomiya :** Fabrication and evaluation of photonic metamaterial crystal, *Applied Physics. A, Materials Science & Processing,* **Vol.112,** 613-619, 2013.
356. **Takahiro Kitada, Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Terahertz Waveforms Generated by Second-Order Nonlinear Polarization in GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavities Using Ultrashort Laser Pulses, *IEEE Photonics Journal,* **Vol.5,** *No.3,* 6500308, 2013.
357. **Takahiro Kitada, Sho Katoh, Toshikazu Takimoto, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Terahertz emission from a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with nonlinear optical susceptibility inversion, *Applied Physics Letters,* **Vol.102,** *No.25,* 251118, 2013.
358. **Takahiro Kitada, Hyuga Ueyama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Ultrafast photocarrier relaxation processes in Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.378,** 485-488, 2013.
359. **Takahiro Kitada, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Wavelength conversion via four-wave mixing in a triple-coupled multilayer cavity, *Applied Physics Letters,* **Vol.103,** *No.10,* 101109, 2013.
360. **Takahiro Kitada, Chiho Harayama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Two-color lasing in a coupled multilayer cavity with InAs quantum dots by optical pumping, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **Vol.10,** *No.11,* 1434-1437, 2013.
361. **Takahiro Kitada, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing in a GaAs/AlAs triple-coupled multilayer cavity for novel ultrafast wavelength conversion devices, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.4S,* 04EG03, 2014.
362. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Wafer-bonded coupled multilayer cavity with InAs quantum dots for two-color emission, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.53,** *No.4S,* 04EG11, 2014.
363. **Takahiro Kitada, Chiho Harayama, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Two-Color Lasing in a Coupled Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots by Optical Pumping, *The 40th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2013), No.TuC1-5,* Kobe Convention Center, Kobe, Japan, May 2013.
364. **Haruyoshi Katayama, Junpei Murooka, Ryota Sato, Masafumi Kimata, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Mikhail Patrashin *and* Iwao Hosako :** Development of Type II Superlattice Detector for Future Space Applications in JAXA, *CLEO-PR & OECC/PS 2013, No.TuC1-3,* Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan, Jul. 2013.
365. **Hiroaki Suzuki, Masanobu Haraguchi, Toshihiro Okamoto, Kohji Oshodani, Toshiro Isu *and* Masuo Fukui :** Emission from metal slit array on Laser Diode electrode through evanescent field scattering process, *The 9th Asia-Pacific Conference on Near-field Optics (APNFO2013),* 132, Singapore, Jul. 2013.
366. **Hiroaki Suzuki, Kohji Oshodani, Masanobu Haraguchi, Masuo Fukui, Toshiro Isu *and* Toshihiro Okamoto :** The light extraction control of the semiconduct or light-emitting devices using plasmonic structure, *Asia Student Photonics Conference 2013 (ASPC2013), No.P-40,* 70, Osaka, Jul. 2013.
367. **Takahiro Kitada, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing in a GaAs/AlAs triple-coupled multilayer cavity for novel ultrafast wavelength conversion devices, *2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2013), No.K-5-3,* Fukuoka, Sep. 2013.
368. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavity by Wafer-Bonding for Two-Color Emission Devices, *2013 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2013), No.K-4-4,* Fukuoka, Sep. 2013.
369. **Hidetada Komatsu, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Clear observation of cavity mode of GaAs/air multilayer structure, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.We2-3,* 2013年7月.
370. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Two-color lasing from wafer-bonded GaAs/AlAs coupled multilayer cavity by optical pumping, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.We2-4,* 2013年7月.
371. **Masanori Ogarane, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Terahertz emission from a (113)B GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with self-assembled InAs quantum dots, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.We2-8,* 2013年7月.
372. **Sho Katoh, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Optical properties of InAs QDs embedded in strain-relaxed InGaAs barriers on (113)B GaAs substrate, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.Fr1-3,* 2013年7月.
373. **盧 翔孟, M Koyama, Y Izumi, S Adachi, S Muto :** Scaling behavior of InAlAs/AlGaAs quantum dots grown on GaAs by molecular beam epitaxy, *第32回電子材料シンポジウム(EMS-32), No.Fr1-5,* 2013年7月.
374. **北田 貴弘, 盧 翔孟, 井須 俊郎 :** 量子ドット結合共振器による二波長レーザ∼新しいテラヘルツ光源を目指して, *第2回 和歌山大・徳島大合同光・ナノテクノロジー研究会,* 2013年8月.
375. **盧 翔孟, Satoru Adachi, Shunichi Muto :** Scaling Behavior of InAlAs/AlGaAs QDs Grown on GaAs by MBE, *第2回 和歌山大・徳島大合同光・ナノテクノロジー研究会,* 2013年8月.
376. **鈴木 裕旭, 大正谷 皓司, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫, 岡本 敏弘 :** プラズモニック構造による半導体発光デバイスの光取り出し制御, *第74回応用物理学会秋期学術講演会, No.17a-P12-14,* 2013年9月.
377. **大柄根 斉宣, 加藤 翔, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B基板上のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs結合共振器へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-D6-13,* 2013年9月.
378. **原山 千穂, 加藤 翔, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドットを利得媒質とするGaAs/AlAs結合共振器のウエハ直接結合による作製と光学特性評価, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-D6-14,* 2013年9月.
379. **小松 秀士, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 微小開口部アレイからの選択エッチングにより作製したGaAs/Air多層膜共振器構造, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.19a-D6-4,* 2013年9月.
380. **北田 貴弘, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs三結合共振器への波長帯域制限したパルス光照射による四光波混合信号光のスペクトル形状, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.19a-D6-3,* 2013年9月.
381. **山内 諒, 盧 翔孟, 小山 正孝, 笹倉 弘理, 武藤 俊一 :** 2種類の拡散原子を有する量子ドット成長モデルでのスケール関数, *2013年第74回応用物理学会秋季学術講演会, No.19p-D3-11,* 2013年9月.
382. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 森田 健, 盧 翔孟, 中河 義典 :** 半導体多層膜結合共振器構造の非線形光学応答とそのデバイス応用, *第9回量子ナノ材料セミナー,* 2013年11月.
383. **原口 雅宣, 鈴木 裕旭, 大正谷 浩司, 井須 俊郎, 岡本 敏弘, 福井 萬壽夫 :** プラズモン利用による発光デバイスの光取り出し制御, *レーザー学会学術講演会 第34回年次大会, No.22a I-3,* 2014年1月.
384. **北田 貴弘, 加藤 翔, 原山 千穂, 大柄根 斉宣, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs 結合共振器によるテラヘルツ波発生への膜厚不均一の影響, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.17a-E15-2,* 2014年3月.
385. **大柄根 斉宣, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速波長変換素子に向けたInAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜三結合共振器の作製, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.17a-E15-3,* 2014年3月.
386. **原山 千穂, 加藤 翔, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドットを利得媒質とするGaAs/AlAs結合共振器による等強度の二波長発振, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.17a-E15-4,* 2014年3月.
387. **盧 翔孟, 松原 修三, 中河 義典, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 分子線エピタキシーによる(001)と(113)B GaAs基板上に成長したInAs量子ドットのフォトルミネッセンスに与えるAlAsキャップの影響, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.18a-E15-1,* 2014年3月.
388. **森田 健, 小田 達也, 石谷 善博, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 通信波長帯InGaAs量子井戸中のスピン緩和, *2014年 第61回応用物理学会春季学術講演会, No.18a-E15-3,* 2014年3月.
389. **鈴木 裕旭, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 半導体レーザの金属電極多重スリットによるレーザ光取出し制御, *LED総合フォーラム2013 in 徳島 論文集,* 57-58, 2013年4月.
390. **Haruyoshi Katayama, Michito Sakai, Junpei Murooka, Masafumi Kimata, Takahiro Kitada, Toshiro Isu, Mikhail Patrashin, Iwao Hosako *and* Yasuhiro Iguchi :** Development Status of Type II Superlattice Infrared Detector in JAXA, *Sensors and Materials,* **Vol.26,** *No.4,* 225-234, 2014.
391. **Masanori Ogarane, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Four-wave mixing in GaAs/AlAs triple-coupled cavity with InAs quantum dots, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.54,** 04DG05, 2015.
392. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Effect of cavity-layer thicknesses on two-color emission in coupled multilayer cavities with InAs quantum dots, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.54,** 04DG10, 2015.
393. **R Yamauchi, Xiangmeng Lu, M Koyama, H Sasakura, Y Nakata *and* S Muto :** Volume distribution by quantum dot growth model with 2 kinds of diffusion atoms, *8th International Conference on Quantum Dots (QD 2014), No.M141,* Pisa, Italy, May 2014.
394. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Effect of non-equivalent cavities on two-color lasing in a GaAs/AlAs coulpled multilayer cavity with InAs quantum dots, *The 41th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2014), No.P57,* Montpellier, France, May 2014.
395. **Xiangmeng Lu, Shuzo Matsubara, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Enhanced photoluminescence form InAs quantum dots with a thin AlAs cap layer grown on (100) and (311)B GaAs substrate, *The 41th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2014), No.Tu-B3-4,* Montpellier, France, May 2014.
396. **Xiangmeng Lu, Shuzo Matsubara, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Suppression of photoluminescence from wetting layer of InAs quantum dots grown on (113)B GaAs with AlAs cap, *The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy(MBE2014), No.TuA2-5,* Flagstaff, Arizona, Sep. 2014.
397. **Masanori Ogarane, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz Emission from a Coupled Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots, *The 18th International Conference on Molecular Beam Epitaxy(MBE2014), No.TuA2-2,* Flagstaff, Arizona, Sep. 2014.
398. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Effect of Cavity-Layer Thicknesses on Two-Color Lasing in a Coupled Multilayer Cavity with InAs Quantum Dots, *2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2014), No.B-3-3,* Tsukuba, Sep. 2014.
399. **Masanori Ogarane, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** GaAs/AlAs triple-coupled cavity with InAs quantum dots for an ultrafast wavelength conversion device via the four-wave-mixing, *2014 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2014), No.PS-7-7,* Tsukuba, Sep. 2014.
400. **盧 翔孟, Shuzo Matsubara, Yoshinori Nakagawa, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Reduced wetting layer and enhanced photoluminescence of InAs quantum dots with AlAs cap grown on (113)B GaAs by molecular beam epitaxy, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Th2-14,* 2014年7月.
401. **Chiho Harayama, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Effect of thickness difference between two cavity layers on two-color lasing in a GaAs/AlAs coupled multilayer cavity with InAs quantum dots, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Fr1-16,* 2014年7月.
402. **Masanori Ogarane, Yukinori Yasunaga, Yoshinori Nakagawa, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** GaAs/AlAs triple-coupled cavity with InAs quantum dots for novel ultrafast wavelength conversion devices, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Fr1-15,* 2014年7月.
403. **Keisuke Murakumo, Hidetada Komatsu, Yoshinori Nakagawa, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Fabrication of a cavity structure with an air layer by selective etching and wafer-bonding, *第33回電子材料シンポジウム(EMS-33), No.Fr1-11,* 2014年7月.
404. **盧 翔孟, 川口 晃弘, 中河 義典, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Effects of AlAs cap and InGaAs Layer on optical property of InAs quantum dots grown on (113)B GaAs by molecular beam epitaxy, *2014年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Da-1,* 2014年7月.
405. **原山 千穂, 上原 敏弘, 中河 義典, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 量子ドット結合共振器による二波長面発光レーザ構造の作製, *2014年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Da-2,* 2014年7月.
406. **村雲 圭佑, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 歪柔和InGaAs層に埋め込んだErドープInAsQDsの内面光伝導特性, *2014年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Da-3,* 2014年7月.
407. **大正谷 皓司, 村中 隆二, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** LED 表面の金属電極に設けたマルチスリットによる光取り出し特性, *2014年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会, No.Ea-4,* 2014年7月.
408. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速キャリア緩和InAs 量子ドット積層構造の面内光伝導, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18a-A27-6,* 2014年9月.
409. **村雲 圭佑, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs/InGaAs量子ドット積層構造の面内光伝導特性の異方性, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A20-13,* 2014年9月.
410. **盧 翔孟, 川口 晃弘, 中河 義典, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** AlAsキャップ付InAs量子ドットのフォトルミネツセンスに対するInGaAs層の影響, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A20-16,* 2014年9月.
411. **北田 貴弘, 原山 千穂, 太田 寛人, 前川 知久, 高田 博文, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** MBE成長とウエハ接合により作製したpn接合を含む量子ドット結合共振器, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A27-2,* 2014年9月.
412. **大柄根 斉宣, 安長 千徳, 中河 義典, 森田 健, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs 量子ドットを有するGaAs/AlAs 多層膜三結合共振器の四光波混合信号測定, *2014年第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A27-3,* 2014年9月.
413. **原山 千穂, 上原 敏弘, 中河 義典, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドットを含むGaAs/AlGaAs結合共振器の電流注入による二波長発光, *2014年 第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.18p-A27-4,* 2014年9月.
414. **森田 健, Ryota Kurosawa, Tatsuya Oda, Yoshihiro Ishitani, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Room temperature spin relaxation in InGaAs quantum wells, *2014年 第75回応用物理学会秋季学術講演会, No.19P-S2-11,* 2014年9月.
415. **北田 貴弘, 井須 俊郎, 森田 健 :** ウエハ接合による結合共振器の作製とテラヘルツ波発生素子への応用, *第5回集積光デバイス技術研究会(IPDA),* 2014年12月.
416. **北田 貴弘, 原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** 二波長面発光レーザーによるテラヘルツ波発生, *レーザー学会第472回研究会,* 2014年12月.
417. **原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 結合共振器構造による二波長面発光とテラヘルツ波発光素子, *電子情報通信学会研究会(レーザ・量子エレクトロニクス研究会LQE),* **Vol.48,** 2015年1月.
418. **盧 翔孟, 川口 晃弘, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B GaAs基板上に成長した量子ドットのPLの温度依存性, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.11a-A10-9,* 2015年3月.
419. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InAs量子ドット積層構造の面内光伝導キャリアの移動度, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.11a-A10-10,* 2015年3月.
420. **北田 貴弘, 原山 千穂, 太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** ウエハ接合界面での光損失を低減した量子ドット結合共振器の作製, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12a-A10-9,* 2015年3月.
421. **大柄根 斉宣, 高本 俊昭, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (113)B基板上のInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs結合共振器へのフェムト秒パルス照射によるテラヘルツ帯差周波発生 (II), *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12p-A14-4,* 2015年3月.
422. **村雲 圭佑, 山岡 裕也, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 量子ドット光伝導スイッチのメサ加工による暗電流の抑制, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12p-A14-12,* 2015年3月.
423. **原山 千穂, 太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合で形成した量子ドット結合共振器による二波長面発光レーザ構造の作製, *2015年第62回応用物理学春季学術講演会, No.12p-A17-8,* 2015年3月.
424. **大正谷 皓司, 村中 隆二, 原口 雅宣, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 金属マルチスリットを組み合わせたLED 構造による表面プラズモンポラリトン発生素子の検討, *第62回応用物理学会春季学術講演会, No.13p-P3-18,* 2015年3月.
425. **北田 貴弘, 原山 千穂, 森田 健, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** テラヘルツLED, *LED総合フォーラム2014-2015,* 2015年1月.
426. **井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器構造によるテラヘルツ光発生素子, *神戸大学フォトニック材料学セミナー,* 2015年1月.
427. **Xiangmeng Lu, Shuzo Matsubara, Yoshinori Nakagawa, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Suppression of photoluminescence from wetting layer of InAs quantum dots grown on (113)B GaAs with AlAs cap, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.425,** 106-109, 2015.
428. **Masanori Ogarane, Sho Katoh, Yoshinori Nakagawa, Ken Morita, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Terahertz emission from a coupled multilayer cavity with InAs quantum dots, *Journal of Crystal Growth,* **Vol.425,** 303-306, 2015.
429. **Hiroto Ota, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication of two-color surface emitting device of a coupled cavity structure with InAs QDs formed by wafer-bonding, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.4S,* 04EH09, 2016.
430. **Keisuke Murakumo, Yuya Yamaoka, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Photoconductivity of Er-doped InAs quantum dots embedded in strain-relaxed InGaAs layers with 1.5mm cw and pulse excitation, *Japanese Journal of Applied Physics,* **Vol.55,** *No.4S,* 04EH12, 2016.
431. **Xiangmeng Lu, Akihiro Kawaguchi, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Temperature Dependence Photoluminescence From InAs Quantum Dots With AlAs Cap Grown on (311)B and (100) GaAs Substrate, *The 42th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2015), No.Mo3GN1.5,* Santa Barbara, CA USA, Jun. 2015.
432. **Keisuke Murakumo, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** In-plane photoconductivity of InAs QDs embedded in strain-relaxed InGaAs layer, *The 42th International Symposium on Compound Semiconductors (ISCS2015), No.Mo3GN1.2,* Santa Barbara, CA USA, Jun. 2015.
433. **Naoto Kumagai, Keisuke Murakumo, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Mobility of in-plane photocurrent of stacked InAs QDs layers in strain-relaxed InGaAs matrix, *17th International Conference on lated Semiconductor Structures(MSS17), No.Mo-PM-14,* Sendai, Jul. 2015.
434. **Xiangmeng Lu, Akihiro Kawaguchi, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Investigation of Carriers Thermal Transfer in Self-asssembled Quantum Dots Grown on (311)B GaAs by Temperature Dependence Photoluminescence, *17th International Conference on lated Semiconductor Structures(MSS17), No.Th-PM-13,* Sendai, Jul. 2015.
435. **Shunicni Muto, Ryo Yamauchi, Osamu Muramatsu, Xiangmeng Lu, Masataka Koyama, Yoshiaki Nakata *and* Hirotaka Sasakura :** 2D Islands by growth model with 2 kinds of diffusive atoms, *17th International Conference on lated Semiconductor Structures(MSS17), No.Th-PM-3,* Sendai, Jul. 2015.
436. **Takahiro Kitada, Masanori Ogarane, Toshiaki Takamoto, Naoto Kumagai, Xiangmeng Lu, Ken Morita *and* Toshiro Isu :** Enhancement of Terahertz Emission from GaAs/AlAs Coupled Multilayer Cavities by InAs Quantum Dots on (113)B-Oriented Substrates, *The Second International Symposium on Frontiers in THz Technology (FTT2015), No.Pos1.24,* Hamamatsu, Aug. 2015.
437. **Keisuke Murakumo, Yuya Yamaoka, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Photoconductivity with 1.55 m excitation of InAs QDs embedded in InGaAs barriers on GaAs substrate, *2015 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2015), No.PS-7-9,* Sapporo, Sep. 2015.
438. **Hiroto Ota, Chiho Harayama, Tomohisa Maekawa, Xiangmeng Lu, Naoto Kumagai, Takahiro Kitada *and* Toshiro Isu :** Fabrication of Two-Color Surface Emitting Device of a Coupled Cavity Structure with InAs QDs Formed by Wafer-Bonding, *2015 International Conference on Solid State Devices and Materials (SSDM2015), No.A-7-6,* Sapporo, Sep. 2015.
439. **盧 翔孟, Akihiro Kawaguchi, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Temperature dependence photoluminescence of quantum dots grown on (311)B GaAs by molecular beam epitaxy, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th2-5,* 2015年7月.
440. **Keisuke Murakumo, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** In-plane photoconductivity of InAs QDs layers embedded in strain-relaxed InGaAs barriers, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th4-10,* 2015年7月.
441. **Hiroto Ota, Chiho Harayama, Tomohisa Maekawa, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Fabrication of Two-Color Surface Emitting Laser of a Coupled Cavity Structure Formed by Wafer-Bonding, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th4-12,* 2015年7月.
442. **Tomohisa Maekawa, Chiho Harayama, Hiroto Ota, 北田 貴弘, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** Two-color emission from coupled cavity structure including InAs QDs formed by wafer bonding, *第34回電子材料シンポジウム(EMS-34), No.Th4-13,* 2015年7月.
443. **太田 寛人, 原山 千穂, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合で形成した量子ドット結合共振器による二波長面発光素子の発光特性, *2015年度 応用物理・物理系学会 中国四国支部合同学術講演会, No.Ca-2,* 2015年8月.
444. **村中 隆二, 大正谷 皓司, 岡本 敏弘, 原口 雅宣, 井須 俊郎, 福井 萬壽夫 :** 金属電極に作製したマルチスリット構造によるLED取り出し光の集光特性に関する研究, *2015年度 応用物理・物理系学会中国四国支部合同学術講演会, No.Ap-9,* 2015年8月.
445. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** テラヘルツ波検出に向けた量子ドット層の面内光伝導特性評価, *第3回 光・ナノテクノロジー研究会 和歌山大・徳島大合同,* 2015年8月.
446. **太田 寛人, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** テラヘルツLEDのための二波長面発光レーザの作製, *第3回 光・ナノテクノロジー研究会 和歌山大・徳島大合同,* 2015年8月.
447. **井須 俊郎, 太田 寛人, 原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘 :** 半導体多層薄膜結合共振器構造によるテラヘルツ発光素子, *2015年電子情報通信学会ソサイエティ大会,* **Vol.CI-1-3,** 2015年9月.
448. **盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** (001)と(113)B GaAs 基板上に成長したInAs 量子ドットに対するSb 照射の効果, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.14p-2W-7,* 2015年9月.
449. **熊谷 直人, 太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 結合共振器を用いた二波長面発光レーザの発振スペクトル注入電流依存性, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.15p-2C-5,* 2015年9月.
450. **太田 寛人, 前川 知久, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** InGaAs/GaAs 多重量子井戸構造を導入した結合共振器による二波長面発光レーザの発振特性, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.16a-2E-7,* 2015年9月.
451. **村雲 圭佑, 熊谷 直人, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 1.5・m パルス励起によるInAs 量子ドット光伝導アンテナ構造の光電流, *2015年度 第76回応用物理学会秋季学術講演会, No.16p-2J-11,* 2015年9月.
452. **北田 貴弘, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器を用いた面型発光素子「テラヘルツLED」の開発, *応用物理学会・テラヘルツ電磁技術研究会 第1回研究討論会/テラヘルツテクノロジーフォーラム 第1回テラテク技術セミナー,* 2015年10月.
453. **井須 俊郎, 北田 貴弘, 熊谷 直人, 盧 翔孟 :** 半導体ナノ構造による新規光デバイスの創製, *徳島大学&宇都宮大学光学連携講演会2015,* 2015年10月.
454. **太田 寛人, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 半導体多層膜結合共振器を用いた二波長面発光レーザー, *レーザー学会学術講演会第36回年次大会,* 2016年1月.
455. **森田 健, 奥村 朗人, 石谷 善博, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 時間分解ファラデー回転法によるInGaAs/InAlAs多重量子井戸における電子g因子測定, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.19p-W241-8,* 2016年3月.
456. **熊谷 直人, 村雲 圭佑, 盧 翔孟, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** Er ドープInAs 量子ドット層のキャリア緩和時間から評価した光電流周波数特性, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.20a-H135-8,* 2016年3月.
457. **太田 寛人, 西村 信耶, 渡邊 健吉, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** ウエハ接合により形成した結合共振器による二波長面発光レーザの特性, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.20p-S321-3,* 2016年3月.
458. **盧 翔孟, 熊谷 直人, 北田 貴弘, 井須 俊郎 :** 超高速波長変換素子に向けたInAs量子ドットを有するGaAs/AlAs多層膜三結合共振器, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.21p-S621-2,* 2016年3月.
459. **北田 貴弘, 太田 寛人, 原山 千穂, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** 結合共振器から生じる二波長レーザー光の時間的コヒーレンスの評価, *2016年 第63回応用物理学会春季学術講演会, No.21p-S621-6,* 2016年3月.
460. **北田 貴弘, 太田 寛人, 盧 翔孟, 熊谷 直人, 井須 俊郎 :** テラヘルツLED, *LED総合フォーラム2015,* **Vol.P-3,** 2015年12月.
461. **村中 隆二, 岡本 敏弘, 井須 俊郎, 原口 雅宣 :** 金属電極に作製したマルチスリット構造によるLED取り出し光の集光特性に関する研究, *LED総合フォーラム2015in徳島 論文集,* 85-86, 2015年12月.